DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35 — DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片.

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.



RF 特性 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	-	0	-	30000	DC–30000	MHz
衰减量	-	-	-	-	1	dB
输入/输出驻波比	-	-	-	-	1.3	-
衰减量平坦度	-	-	-	-	±0.5	dB

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大输入功率	-	-	-	30	dBm

环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	125	°C

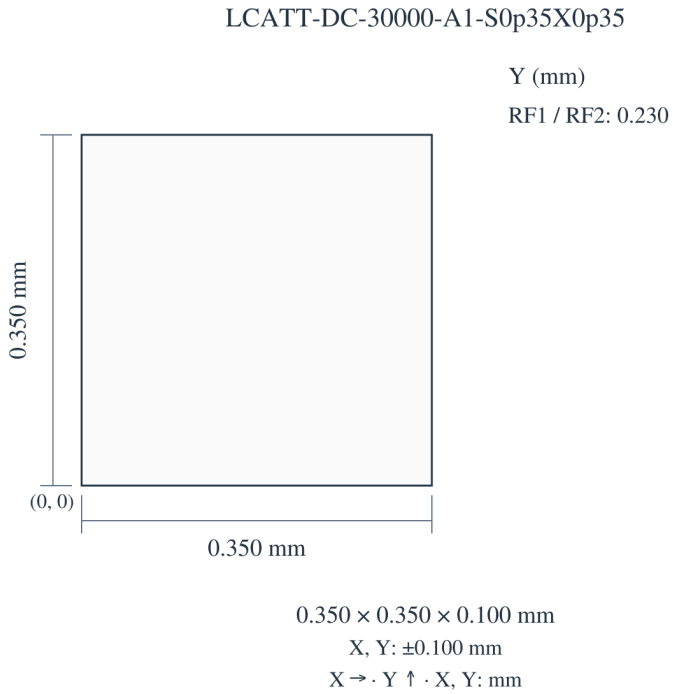
压点定义

序号	功能符号	mm
1	GND	0.100 × 0.050
2	RF1	0.132 × 0.087
3	RF2	0.132 × 0.087
4	GND	0.100 × 0.050

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	0.35 × 0.35 × 0.1	mm

外形与已标注坐标的尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。



当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

裸片集成与偏置时序

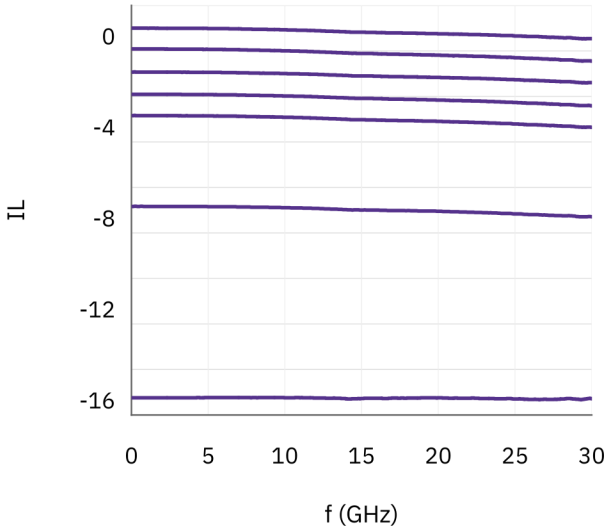
芯片背面需要可靠接地。

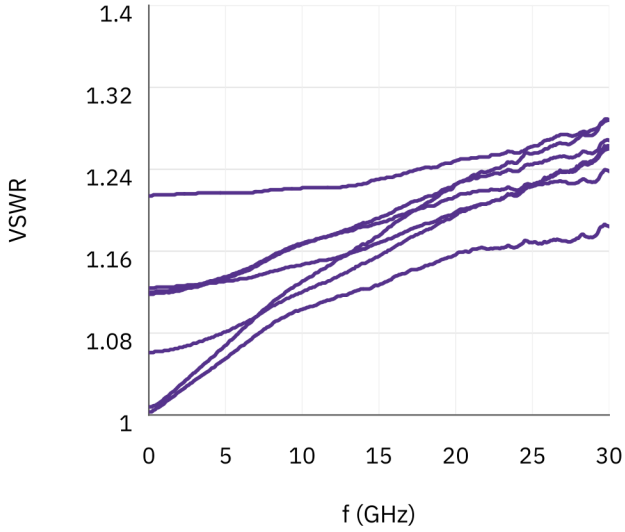
性能曲线

请结合每张图标明的工作条件阅读。

系列参考曲线 — 端口匹配、插入损耗。

图注：TA=+25°C。 图中读数为近似值。 此组曲线为系列 7 款型号共用参考。各曲线未按型号区分，IL 轴未标明单位。





文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。